Реєстраційна картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0106U007386

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 31-07-2006

Статус виконавця: співвиконавець

Номер РК головного виконавця:

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 07 - завдання органів виконавчої влади

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 24 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02125438

Місцезнаходження: вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Дрогобицький р-н., Львівська обл., 82100, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380324431276, 380324410474

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науково-виробниче підприємство "Електрон-Карат"-дочірнє підприємство ПрАТ "Концерн-Електрон"

Код за ЄДРПОУ: 23273999

Місцезнаходження: вул. Стрийська, 202, м. Львів, Львівська обл., 79031, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2631065

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Синтез зразків халькогенідних склоподібних напівпровідників, виготовлення зразків високої оптичної якості та оптимізація їх оптоелектронних параметрів

Назва роботи англійською:

Synthesis of chalcogenide glassy-like semiconductors, fabrication of samples with high optical quality and optimization of their optoelectronic parameters

Мета роботи українською:

Метою роботи є синтез зразків бінарних, псевдобінарних, потрійних стехіометричних і нестехіометричних систем халькогенідних склоподібних напівпровідників (ХСН), виготовлення зразків високої оптичної якості та оптимізація їх оптоелектронних параметрів

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Будуть отримані оптимальні оптоелектронні параметри функціональних середовищ на основі зразків ХСН шляхом їх хіміко-технологічної модифікації, включаючи і посттехнологічну обробку високо-енергетичним іонізуючим гама-випромінюванням

Галузь застосування:

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Шпотюк Олег Йосипович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Синтез зразків бінарних та псевдо-бінарних систем ХСН, виготовлення зразків високої оптичної якості, оптимізація їх оптоелектронних параметрів

Початок етапу: 07.2006

Закінчення етапу: 12.2006

Вид звітного документа: Без звіту

Номер етапу: 2

Назва етапу: Синтез зразків потрійних стехіометричних та нестехіометричних систем ХСН, виготовлення зразків високої оптичної якості, оптимізація їх оптоелектронних параметрів

Початок етапу: 01.2007

Закінчення етапу: 12.2007

Вид звітного документа: Без звіту

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 537.311.322, 539.216.2

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Ваків Микола Михайлович

д. т. н.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.